

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 5 月 30 日 (2013.5.30)

【公開番号】特開 2011-253987 (P2011-253987A)
 【公開日】平成 23 年 12 月 15 日 (2011.12.15)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-050
 【出願番号】特願 2010-127802 (P2010-127802)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 31/10 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 31/10 A

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 4 月 11 日 (2013.4.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 2 】

実施の形態 2 .

図 8 は、実施の形態 2 に係る半導体受光素子を示す断面図である。n 型 I n P 基板 3 2 の裏面は曲面である。これにより、n 型 I n P 基板 3 2 の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 3 】

実施の形態 3 .

図 9 は、実施の形態 3 に係る半導体受光素子を示す断面図である。n 型 I n P 基板 3 2 の裏面は、斜めにカットされて、入射光の入射方向に対して傾いている。これにより、n 型 I n P 基板 3 2 の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 4 】

実施の形態 4 .

図 10 は、実施の形態 4 に係る半導体受光素子を示す断面図である。n 型 I n P 基板 3 2 の裏面は、n 型 I n P 基板 3 2 の表面や n 型 I n P 層 3 6 の表面などに比べて荒れている。これにより、n 型 I n P 基板 3 2 の裏面で反射されて半導体発光素子に戻る反射光が更に小さくなるため、戻り光不良を更に確実に防ぐことができる。